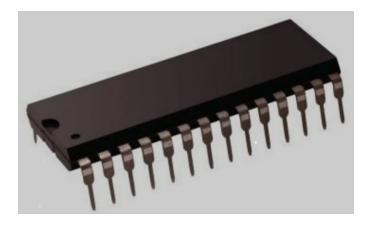
# **EEPROM** interna

EEPROM (também escrita **E2PROM**, e pronunciada "e-e-prom") é um tipo de memória "não-volátil" usada para armazenar dados. Ser "não-volátil" significa que esta memória armazena dados mesmo quando não está energizada, diferente da memória RAM.

A sigla EEPROM significa **E**lectrically-**E**rasable **P**rogrammable **R**ead-**O**nly **M**emory, ou memória só de leitura eletricamente programável. O nome não faz jus ao funcionamento real, pois é possível ler e escrever desta memória. Este nome ficou assim devido a sua história, que começou com a memória ROM (Read only memory):



O disco acima, famoso CD ROM, é um tipo de memória ROM. Eles eram gravados na fábrica e não era possível regravá-los, apenas lê-los. Além disso, a memória interna deles tinham uma data de validade, algo em torno de 10-50 anos. Mas também existiram os chips PROM.



Estes chips possuíam um esquema de gravação físico, onde fusíveis internos literalmente queimavam para armazenar os valores. Portanto, ela só podia ser gravada uma vez. As próximas memórias que surgiram foram as EPROM:



Elas necessitavam de uma luz ultravioleta sendo inserida neste painel acima para que os dados sejam apagados. Depois era só reprograma-las. Os tipos de memória mais atuais são as EEPROM, que são eletricamente programáveis, portanto, podem ser programadas diretamente via hardware. Ainda, hoje em dia essas memórias foram substituídas pela memória Flash, a mesma utilizada em pendrives e SSD's. Mas a EEPROM ainda é muito utilizada devido ao seu baixo custo.

#### A memória EEPROM do PIC

Vários microcontroladores da microchip possuem um espaço de memória EEPROM interno para salvar dados importantes. Essa memória possui um ciclo de 100000 leituras/escritas e até 40 anos de armazenamento de dados.

TABLE 1: PIC18(L)F2X/4XK22 FAMILY TYPES

		Program Da Memory Mem		ata nory	IS <sup>(2)</sup>			e)	e)	MSSP			٥r				_	76
Device	Flash (Bytes)	# Single-Word Instructions	SRAM (Bytes)	EEPROM (Bytes)	1/0(1)	10-bit A/D Channels <sup>(2)</sup>	CCP	ECCP (Full-Bridge)	ECCP (Half-Bridge)	SPI	l²C	EUSART	Comparator	СТМО	BOR/LVD	SR Latch	8-bit Timer	16-bit Timer
PIC18(L)F23K22	8K	4096	512	256	25	19	2	1	2	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4
PIC18(L)F24K22	16K	8192	768	256	25	19	2	1	2	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4
PIC18(L)F25K22	32K	16384	1536	256	25	19	2	1	2	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4
PIC18(L)F26K22	64k	32768	3896	1024	25	19	2	1	2	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4
PIC18(L)F43K22	8K	4096	512	256	36	30	2	2	1	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4
PIC18(L)F44K22	16K	8192	768	256	36	30	2	2	1	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4
PIC18(L)F45K22	32K	16384	1536	256	36	30	2	2	1	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4
PIC18(L)F46K22	64k	32768	3896	1024	36	30	2	2	1	2	2	2	2	Υ	Υ	Υ	3	4

Os modelos PIC16 também possuem uma certa quantidade de memória EEPROM interna:

Program Memory		Data	EEDDOM		40 bit	ССР	MSSP			Timore		
Device	Bytes	# Single Word Instructions	SRAM (Bytes)	(Bytes)	I/O	10-bit A/D (ch)		SPI	Master I <sup>2</sup> C	USART	Timers 8/16-bit	Comparators
PIC16F873A	7.2K	4096	192	128	22	5	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2
PIC16F874A	7.2K	4096	192	128	33	8	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2
PIC16F876A	14.3K	8192	368	256	22	5	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2
PIC16F877A	14.3K	8192	368	256	33	8	2	Yes	Yes	Yes	2/1	2

Ela funciona com arquitetura de endereço/valor padrão das memórias. Porém, para acessar estes endereços, é necessário utilizar o registrador EECON1.

REGISTER 7-1: EECON1: DATA EEPROM CONTROL 1 REGISTER

W = Writable bit

Legend: R = Readable bit

bit 0

R/W-x	R/W-x	U-0	R/W-0	R/W-x	R/W-0	R/S-0	R/S-0
EEPGD	CFGS	_	FREE	WRERR	WREN	WR	RD
bit 7				•			bit 0

S = Bit can be	set by software, but not cleared	U = Unimplemented bit	, read as '0'							
-n = Value at P	OR '1' = Bit is set	'0' = Bit is cleared	x = Bit is unknown							
bit 7	EPGD: Flash Program or Data EEPROM Memory Select bit									
	1 = Access Flash program memory 0 = Access data EEPROM memory									
bit 6	CFGS: Flash Program/Data EEPROM	or Configuration Select bit								
	<ul><li>1 = Access Configuration registers</li><li>0 = Access Flash program or data EEF</li></ul>	PROM memory								
bit 5	Unimplemented: Read as '0'									
bit 4	FREE: Flash Row (Block) Erase Enable	e bit								
	<ul><li>1 = Erase the program memory block a (cleared by completion of erase op</li><li>0 = Perform write-only</li></ul>	•	e next WR command							
bit 3	WRERR: Flash Program/Data EEPROI	M Error Flag bit <sup>(1)</sup>								
	<ul> <li>1 = A write operation is prematurely terested operation, or an improper write attered</li> <li>0 = The write operation completed</li> </ul>	` ,	self-timed programming in norm							
	·	=								
bit 2	WREN: Flash Program/Data EEPROM  1 = Allows write cycles to Flash progra  0 = Inhibits write cycles to Flash progra	m/data EEPROM								
bit 1	WR: Write Control bit  1 = Initiates a data FEPROM erase/write	te cycle or a program memor	v erase cycle or write cycle							
bit 1	, , ,		y erase cycle or write c							

(The operation is self-timed and the bit is cleared by hardware once write is complete.

1 = Initiates an EEPROM read (Read takes one cycle. RD is cleared by hardware. The RD bit can only be set (not cleared) by software. RD bit cannot be set when EEPGD = 1 or CFGS = 1.)

Além do registrador EECON1, este modo também os registradores:

0 = Write cycle to the EEPROM is complete

0 = Does not initiate an EEPROM read

RD: Read Control bit

The WR bit can only be set (not cleared) by software.)

- EEDATA → onde é inserido o dado de 8 bits a ser armazenado na memória
- EEADR → Endereço da memória onde o dado será armazenado
- EEADRH → Registrador alto de endereçamento para casos onde a memória ultrapassa 256 bytes
- EECON2 → Registrador auxiliar

### Config básica para gravação na EEPROM

```
char STATUS_GIE = 0;
EEADR = endereco; // Endereço a ser gravado
EEDATA = byte; // Byte a ser gravado
EECON1.EEPGD = 0; // Aposta para a memória
EECON1.CFGS = 0; // Acesso ao controle da EEPROM
EECON1.WREN = 1; // Habilita modo de gravação da EEPROM

STATUS_GIE = INTCONbits.GIE; // Salvo a situação da interrupção
INTCON.GIEH = 0; // Desativo as interrupções globais

EECON2 = 0X55; // Procedimento obrigatório p/ escrita
EECON2 = 0XAA; // Procedimento obrigatório p/ escrita
EECON1.WR = 1; // Realiza a gravação da EEPROM
While(EECON1.WR == 1); // Aguarda o término da gravação

INTCON.GIEH = STATUS_GIE; // Reativo as interrupções globais

EECON1.WREN = 0; // Desabilita o modo de gravação
```

#### **Config para leitura EEPROM**

```
char result;

EEADR = endereço; // Endereço da EEPROM

EECON1.CFGS = 0; // Acesso ao controle da memória EEPROM

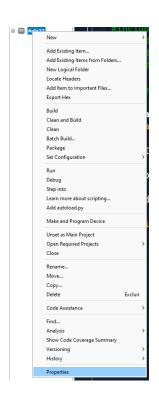
EECON1.EEPGD = 0; // Aponta para a memória EEPROM

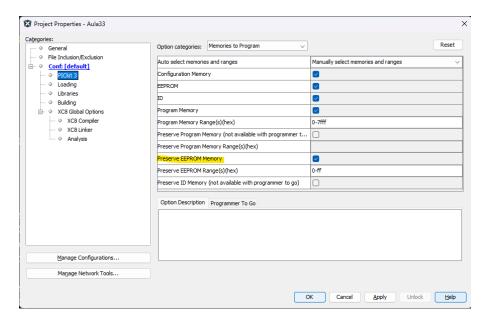
EECON1.RD = 1; // Inicia a Leitura do EEPROM

asm("nop");
asm("nop");
result = EEDATA; // O valor da leitura está em EEDATA
```

# **Observações**

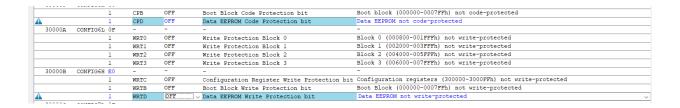
Por padrão, gravar a memória de programa do microcontrolador apaga toda a EEPROM interna. Mas é possível alterar isto clicando com o botão direito na pasta do projeto → propriedades → PicKit3 → Preserve EEPROM memory. Habilite esta funcionalidade para preservar a memória EEPROM.





## Bits de configuração

O PIC18F45k22 possui dois bits de configuração para a EEPROM. Ao acioná-los, a leitura ou a escrita da EEPROM fica protegida. Mesmo protegida, o código interno do microcontrolador ainda é livre para ler ou escrever da memória EEPROM. Isso pode variar de microcontrolador para microcontrolador.



#### **SFR**

Os SFRs (Special Function Registers) no MPLAB X são registradores especiais que controlam e monitoram o funcionamento do microcontrolador. Eles são responsáveis por controlar periféricos, como entradas e saídas, comunicação serial, timers, entre outros. Os SFRs são registradores de hardware que estão diretamente conectados ao processador do microcontrolador e podem ser acessados por meio de instruções de leitura e gravação.